



AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Wydział Elektryczny



Oferta technologiczna

Nazwa technologii
Sposób i układ do pomiaru rezystancji termicznej tranzystora bipolarnego mocy z izolowaną bramką
Dziedzina nauki/Gałąź przemysłu
Elektronika
Opis technologii
Sposób i układ do pomiaru rezystancji termicznej tranzystora IGBT realizowany przy wykorzystaniu pośredniej stałoprądowej metody elektrycznej. W charakterze parametru termo czułego wykorzystywane jest napięcie sterujące tranzystor. W oparciu o proste pomiary stałoprądowe i wzór analityczny wyznaczana jest wartość rezystancji termicznej.
Korzyści z wdrożenia technologii / możliwości zastosowania
Korzystnym skutkiem zastosowania sposobu i układu według wynalazku jest wyznaczenie rezystancji termicznej w typowych warunkach pracy mierzonego tranzystora bez potrzeby zasilania impulsowego tego elementu i bez stosowania kosztownych szybkich woltomierzy oraz wyeliminowanie błędu pomiaru związanego z kluczowaniem źródła zasilającego tranzystor. Zmierzona rezystancja termiczna umożliwia wyznaczenie wartości temperatury wnętrza tranzystora IGBT przy znanych warunkach jego zasilania.
Słowa kluczowe
Pomiary parametrów cieplnych, tranzystor IGBT, rezystancja termiczna.
Zaawansowanie technologii
<input type="checkbox"/> projekt w fazie badań <input type="checkbox"/> technologia demonstracyjna X technologia gotowa do wdrożenia <input type="checkbox"/> prototyp <input type="checkbox"/> produkt dostępny na rynku
Ochrona prawna/ Rodzaj ochrony
Ochrona prawna: TAK Rodzaj ochrony: patent nr 224783
Dane kontaktowe
Akademia Morska w Gdyni Wydział Elektryczny, Katedra Elektroniki Morskiej ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia Osoba do kontaktu: Krzysztof Górecki k.gorecki@we.am.gdynia.pl , tel.: 58 5586 448